

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 2月16日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-040430

[ST.10/C]:

[JP2001-040430]

出 願 人

Applicant(s):

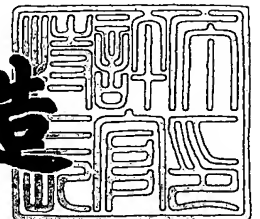
キヤノン株式会社

RECEIVED
MAY 08 2002
TC 1100

2002年 3月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3014208

【書類名】 特許願

【整理番号】 4360015

【提出日】 平成13年 2月16日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 29/772

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法並びにインクジェットヘッド

【請求項の数】 7

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 下津佐 峰生

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

 【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

 【識別番号】 100065385

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 山下 穰平

 【電話番号】 03-3431-1831

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 010700

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9703871

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法並びにインクジェットヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項1】 スイッチ素子とこのスイッチ素子を駆動するための回路を同一基体上に形成した半導体装置において、

前記スイッチ素子は、第1導電型の半導体基体の一主面に設けられた第2導電型の第1の半導体領域と、

この第1の半導体領域に設けられた第1導電型の第2の半導体領域と、

この第2の半導体領域と前記第1の半導体領域のPN接合が終端する表面に絶縁膜を介して設けられた第1のゲート電極と、

前記第2の半導体領域の表面側に前記第1のゲート電極の一方の端部に整合した第2導電型の第1のソース領域と、

前記第1の半導体領域の表面側に設けられた第2導電型の第1のドレイン領域と、を有する第1のMIS型電界効果トランジスタであり、

前記スイッチ素子を駆動するための回路は、前記第1導電型の半導体基体の表面上に絶縁膜を介して設けられた第2のゲート電極と、

この第2のゲート電極の一方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第2導電型の低濃度ドレイン領域と、

前記第2のゲート電極の他方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第2導電型の第2のソース領域と、

前記第2のゲート電極の前記一方の端部側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離れて設けられた第2導電型の第2のドレイン領域と、を有する第2のMIS型電界効果トランジスタを具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 複数個のスイッチ素子とこれら複数個のスイッチ素子を駆動するための回路で構成されるトランジスタアレイを同一基体上に形成した半導体装置において、

前記スイッチ素子は、第1導電型の半導体基体の一主面に設けられた第2導電型の第1の半導体領域と、

この第1の半導体領域を分離するように設けられた前記第1の半導体領域より

深い第 1 導電型の第 2 の半導体領域と、

この第 2 の半導体領域と前記第 1 の半導体領域の P N 接合が終端する表面に絶縁膜を介して設けられた第 1 のゲート電極と、

前記第 2 の半導体領域の表面側に前記第 1 のゲート電極の一方の端部に整合して設けられた第 2 導電型の第 1 のソース領域と、

前記第 1 の半導体領域の表面側に設けられた第 2 導電型の第 1 のドレイン領域と、を有する第 1 の M I S 型電界効果トランジスタであり、

前記スイッチ素子を駆動するための回路は、前記第 1 導電型の半導体基体の表面上に絶縁膜を介して設けられた第 2 のゲート電極と、

この第 2 のゲート電極の一方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第 2 導電型の低濃度ドレイン領域と、

前記第 2 のゲート電極の他方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第 2 導電型の第 2 のソース領域と、

前記第 2 のゲート電極の前記一方の端部側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離れて設けられた第 2 導電型の第 2 のドレイン領域と、を有する第 2 の M I S 型電界効果トランジスタを具備することを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】 前記第 2 の M I S 型電界効果トランジスタは、第 1 の M I S 型電界効果トランジスタに対し、オン抵抗が 1 倍以上で、且つ動作耐圧が $2/3$ 倍以下であることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の半導体装置。

【請求項 4】 前記第 2 の M I S 型電界効果トランジスタは、第 1 の M I S 型電界効果トランジスタに対し、オン抵抗が 1 倍以上で、且つ動作範囲内での最大基板電流が 10 倍以上であることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の半導体装置。

【請求項 5】 スイッチ素子とこのスイッチ素子を駆動するための回路を同一基体上に形成する半導体装置の製造方法であって、

第 1 導電型の半導体基体の表面に、第 2 導電型の第 1 の半導体領域を形成する工程と、

この第 1 の半導体領域上に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記第 1 の半導体領域の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第 1 のゲート電極を

、前記半導体基体の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第2のゲート電極を形成する工程と、

前記第1のゲート電極をマスクとした第1導電型の不純物のイオン注入により、前記第1の半導体領域中に、この第1の半導体領域より高濃度な第1導電型の第2の半導体領域を形成する工程と、

前記第2のゲート電極をマスクとした第2導電型の不純物のイオン注入により、前記半導体基体中に、第2導電型の低濃度ドレイン領域を形成する工程と、

前記第2の半導体領域の表面側に前記第1のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第2導電型の第1のソース領域を、前記第1の半導体領域の表面側に第2導電型の第1のドレイン領域を、前記半導体基体の表面側に前記第2のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第2導電型の第2のソース領域を、前記第2のゲート電極側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離して第2導電型の第2のドレイン領域を、形成する工程と、

含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項6】 スイッチ素子とこのスイッチ素子を駆動するための回路を同一基体上に形成する半導体装置の製造方法であって、

第1導電型の半導体基体の表面に、第2導電型の第1の半導体領域を形成する工程と、

この第1の半導体領域上に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記第1の半導体領域の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極を、前記半導体基体の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第2のゲート電極を形成する工程と、

前記第1のゲート電極をマスクとした第1導電型の不純物のイオン注入により、前記第1の半導体領域を電氣的に分離する、前記第1の半導体領域より高濃度な第1導電型の第2の半導体領域を形成する工程と、

前記第2のゲート電極をマスクとした第2導電型の不純物のイオン注入により、前記半導体基体中に、第2導電型の低濃度ドレイン領域を形成する工程と、

前記第2の半導体領域の表面側に前記第1のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第2導電型の第1のソース領域を、前記第1の半導体領域の表面側に

第2導電型の第1のドレイン領域を、前記半導体基体の表面側に前記第2のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第2導電型の第2のソース領域を、前記第2のゲート電極側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離して第2導電型の第2のドレイン領域を、形成する工程と、

を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項7】 請求項1又は2記載の半導体装置と、前記半導体装置のスイッチ素子に接続された電気熱変換体と、インクを吐出する吐出口とを備えたことを特徴とするインクジェットヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、MIS (Metal Insulator Semiconductor)型電界効果トランジスタを含む半導体装置に関し、特に複写機、ファクシミリ、ワードプロセッサ、コンピュータ等の出力用端末として用いるインクジェットプリンタのような記録装置に搭載して好適な半導体装置及びその製造方法並びにインクジェットヘッドに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、各種出力用端末として用いられる記録装置には、その記録ヘッドとして、電気熱変換素子とこの電気熱変換素子をスイッチする素子（以下、スイッチ素子）、およびそのスイッチ素子を駆動するための回路が同一基体上に搭載されている。

【0003】

図9は、従来の構成による記録ヘッドの一部分を示す模式的な断面図である。901は単結晶シリコンからなる半導体基体である。912はp型のウェル領域、908はn型のドレイン領域、916はn型の電界緩和ドレイン領域、907はn型のソース領域、914はゲート電極であり、これらでMIS型電界効果トランジスタを用いたスイッチ素子930を形成している。917は蓄熱層、および絶縁層としての酸化シリコン層、918は熱抵抗層としての窒化タンタル膜、

919は配線としてのアルミニウム合金膜、および920は保護層としての窒化シリコン膜であり、以上で記録ヘッドの基体940を形成している。ここでは950が発熱部となり、960からインクが吐出される。また、天板970は基体940と協働して液路980を画成している。

【0004】

ところで、前記構造の記録ヘッドおよびスイッチ素子に対して数多くの改良が加えられてきたが、近年製品に対して、高速駆動化、省エネルギー化、高集積化、低コスト化、および高性能化がより一層求められるようになった。このため、図9に示すようなスイッチ素子として使用されるMIS型電界効果トランジスタ930を半導体基体901内に複数個作り込み、これらのMIS型電界効果トランジスタ930を単独、または複数個同時に動作させ、結線されている電気熱変換素子を駆動させる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、電気熱変換素子を駆動させるために必要となる大電流下においては、従来のMIS型電界効果トランジスタ930を機能させると、ドレイン-ウエル間のpn逆バイアス接合部は高電界に耐えられずリーク電流を発生させ、スイッチ素子として要求される耐圧を満足することができなかった。更に、スイッチ素子として使用されるMIS型電界効果トランジスタのオン抵抗が大きいと、ここでの電流の無駄な消費によって、電気熱変換素子を駆動するために必要な電流が得られなくなるという解決すべき問題があった。

【0006】

また、耐圧の問題を解決するためには、図10に示すようなMIS型電界効果トランジスタ1030が考えられる。このMIS型電界効果トランジスタの構造は通常の構造とは異なり、ドレインの中にチャネルを作り込むことによって、耐圧を決定しているドレインの深さを深く、また、低濃度で作り込むことが可能となり、耐圧の問題を解決できる。

【0007】

しかしながら、このMIS型電界効果トランジスタ1030はスイッチ素子と

しての特性は前述のとおり高性能ではあるが、アナログ素子としては不自由な素子である。アナログ素子はマスクでチャネル長を調整することにより、任意のしきい値電圧を設計する。また、基板にバックゲート電圧がかかる回路構成に耐えるものでなければならない。

【 0 0 0 8 】

このM I S型電界効果トランジスタ1 0 3 0のチャネル長はベース層とソース層の横方向拡散量の差で決まる。そのため、チャネル長は通常のM I S型電界効果トランジスタに比べて短く、また、マスクで調整することもできない。

【 0 0 0 9 】

また、スイッチ素子にこのM I S型電界効果トランジスタ1 0 3 0を用い、その他の部分には通常のM I Sトランジスタを用いた場合は、スイッチ素子を駆動するレベルシフト素子の耐圧が足りなくなってしまう。

【 0 0 1 0 】

これを具体的に述べると、一般的なドライバI Cの信号は図1 1に示すように伝わる。まず、入力信号が5. 0 V、ないし3. 3 VをH iとして与えられる。その信号がデコーダにより、任意のB i tに伝わる。その後、信号はソース設置のCM O S構成のインバータ回路をとおり、スイッチM O Sのゲートに入力される。

【 0 0 1 1 】

ここで重要なのはCM O S構成のインバータ回路に与えられるV H Tという任意の電圧である。このV H TはスイッチM O Sのオン抵抗が最小になるように設計される必要がある。スイッチM O Sのオン抵抗が最小になればスイッチM O Sの寸法を最小にできるからである。

【 0 0 1 2 】

このV H Tは外部入力されないため、I C内で電圧レベルを変換する必要がある。このように電圧レベルを変換するレベルシフト回路には図1 2に示す順方向ダイオードを直列接続して定電圧を得る方法もあるが、1個のダイオードの特性ばらつきがかけ算で効いてくる。また、電流依存の電圧変動を防ぐためにダイオードのサイズを大きくする必要があるため現実的ではない。

【 0 0 1 3 】

そのため、レベルシフト回路にはソースホロワのトランジスタを介在させ、定電圧を得る方法が一般的である。このレベルシフト回路を図 1 1 に組み込んだ場合、図 1 3 のようになる。

【 0 0 1 4 】

このとき、スイッチ MOS を駆動するドレイン電圧 V_H を 3 0 V、 V_{GNDH} を 0 V として、ゲート電圧 V_{HT} を 1 2 V にする場合、レベルシフトに用いるソースホロワのトランジスタには、- 1 2 V のバックゲート電圧がかかり、またドレイン-ソース間耐圧が 1 8 V 以上必要になることがわかる。

【 0 0 1 5 】

このようにスイッチ素子をスイッチ特性の優れた M I S 型電界効果トランジスタ構造にすると、任意のしきい値電圧を設定でき、バックゲート電圧に耐えるアナログ特性を有する中耐圧素子が不足するという解決すべき問題があった。

【 0 0 1 6 】

そこで本発明は、前述の課題を解決し、大電流、高耐圧で高速駆動、省エネルギー、高集積化、および低コスト化が達成できる、M I S 型電界効果トランジスタを含む高性能な半導体装置を提供することを目的とする。

【 0 0 1 7 】

【課題を解決するための手段】

上述の課題を解決するため、本発明は、スイッチ素子とこのスイッチ素子を駆動するための回路を同一基体（1 0 1、1 1 1）上に形成した半導体装置において、前記スイッチ素子は、第 1 導電型の半導体基体（1 0 1、1 1 1）の一主面に設けられた第 2 導電型の第 1 の半導体領域（1 0 2）と、この第 1 の半導体領域に設けられた第 1 導電型の第 2 の半導体領域（1 0 5）と、この第 2 の半導体領域と前記第 1 の半導体領域の P N 接合が終端する表面に絶縁膜（1 0 3）を介して設けられた第 1 のゲート電極（1 0 4）と、前記第 2 の半導体領域の表面側に前記第 1 のゲート電極の一方の端部に整合した第 2 導電型の第 1 のソース領域（1 0 7）と、前記第 1 の半導体領域の表面側に設けられた第 2 導電型の第 1 のドレイン領域（1 0 8）と、を有する第 1 の M I S 型電界効果トランジスタであ

り、前記スイッチ素子を駆動するための回路は、前記第 1 導電型の半導体基体（1 0 1、1 1 1）の表面上に絶縁膜（1 1 3）を介して設けられた第 2 のゲート電極（1 1 4）と、この第 2 のゲート電極の一方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第 2 導電型の低濃度ドレイン領域（1 1 6）と、前記第 2 のゲート電極の他方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第 2 導電型の第 2 のソース領域（1 1 7）と、前記第 2 のゲート電極の前記一方の端部側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離れて設けられた第 2 導電型の第 2 のドレイン領域（1 1 8）と、を有する第 2 の M I S 型電界効果トランジスタを具備することを特徴とする。

【 0 0 1 8 】

又、本発明は、複数個のスイッチ素子とこれら複数個のスイッチ素子を駆動するための回路で構成されるトランジスタアレイを同一基体上に形成した半導体装置において、前記スイッチ素子は、第 1 導電型の半導体基体（3 0 1）の一主面に設けられた第 2 導電型の第 1 の半導体領域（3 0 2）と、この第 1 の半導体領域を分離するように設けられた前記第 1 の半導体領域より深い第 1 導電型の第 2 の半導体領域（3 0 5）と、この第 2 の半導体領域と前記第 1 の半導体領域の P N 接合が終端する表面に絶縁膜（3 0 3）を介して設けられた第 1 のゲート電極（3 0 4）と、前記第 2 の半導体領域の表面側に前記第 1 のゲート電極の一方の端部に整合して設けられた第 2 導電型の第 1 のソース領域（3 0 7）と、前記第 1 の半導体領域の表面側に設けられた第 2 導電型の第 1 のドレイン領域（3 0 8）と、を有する第 1 の M I S 型電界効果トランジスタであり、前記スイッチ素子を駆動するための回路は、前記第 1 導電型の半導体基体の表面上に絶縁膜を介して設けられた第 2 のゲート電極と、この第 2 のゲート電極の一方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第 2 導電型の低濃度ドレイン領域と、前記第 2 のゲート電極の他方の端部に整合して前記半導体基体に設けられた第 2 導電型の第 2 のソース領域と、前記第 2 のゲート電極の前記一方の端部側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離れて設けられた第 2 導電型の第 2 のドレイン領域と、を有する第 2 の M I S 型電界効果トランジスタを具備することを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

とりわけ、前記第2のMIS型電界効果トランジスタは、第1のMIS型電界効果トランジスタに対し、オン抵抗が1倍以上で、且つ動作耐圧が2/3倍以下であることが好ましい。

【0020】

又、前記第2のMIS型電界効果トランジスタは、第1のMIS型電界効果トランジスタに対し、オン抵抗が1倍以上で、且つ動作範囲内での最大基板電流が10倍以上であることが好ましい。

【0021】

本発明のスイッチ素子とこのスイッチ素子を駆動するための回路を同一基体上に形成する半導体装置の製造方法は、第1導電型の半導体基体（501）の表面に、第2導電型の第1の半導体領域（502）を形成する工程と、この第1の半導体領域上に、ゲート絶縁膜（503）を形成する工程と、前記第1の半導体領域の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第1のゲート電極（504）を、前記半導体基体の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第2のゲート電極（514）を形成する工程と、前記第1のゲート電極をマスクとした第1導電型の不純物のイオン注入により、前記第1の半導体領域中に、この第1の半導体領域より高濃度な第1導電型の第2の半導体領域（505）を形成する工程と、前記第2のゲート電極をマスクとした第2導電型の不純物のイオン注入により、前記半導体基体中に、第2導電型の低濃度ドレイン領域（516）を形成する工程と、前記第2の半導体領域の表面側に前記第1のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第2導電型の第1のソース領域（507）を、前記第1の半導体領域の表面側に第2導電型の第1のドレイン領域（508）を、前記半導体基体の表面側に前記第2のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第2導電型の第2のソース領域（517）を、前記第2のゲート電極側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離して第2導電型の第2のドレイン領域（518）を、形成する工程と、含むことを特徴とする。

【0022】

又、本発明のスイッチ素子とこのスイッチ素子を駆動するための回路を同一基体上に形成する半導体装置の製造方法は、第1導電型の半導体基体（801）の

表面に、第 2 導電型の第 1 の半導体領域（802）を形成する工程と、この第 1 の半導体領域上に、ゲート絶縁膜（803）を形成する工程と、前記第 1 の半導体領域の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第 1 のゲート電極（804）を、前記半導体基体の表面に前記ゲート絶縁膜を介して第 2 のゲート電極（814）を形成する工程と、前記第 1 のゲート電極をマスクとした第 1 導電型の不純物のイオン注入により、前記第 1 の半導体領域を電氣的に分離する、前記第 1 の半導体領域より高濃度な第 1 導電型の第 2 の半導体領域（805）を形成する工程と、前記第 2 のゲート電極をマスクとした第 2 導電型の不純物のイオン注入により、前記半導体基体中に、第 2 導電型の低濃度ドレイン領域（816）を形成する工程と、前記第 2 の半導体領域の表面側に前記第 1 のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第 2 導電型の第 1 のソース領域（807）を、前記第 1 の半導体領域の表面側に第 2 導電型の第 1 のドレイン領域（808）を、前記半導体基体の表面側に前記第 2 のゲート電極をマスクとしたイオン注入により第 2 導電型の第 2 のソース領域（817）を、前記第 2 のゲート電極側の前記低濃度ドレイン領域の端部から離して第 2 導電型の第 2 のドレイン領域（818）を、形成する工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【0023】

更に、本発明のインクジェットヘッドは、上記半導体装置と、前記半導体装置のスイッチ素子に接続された電気熱変換体と、インクを吐出する吐出口とを備えたことを特徴とする。

【0024】

【発明の実施の形態】

次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図 1（a）、（b）は、それぞれ本発明によるスイッチ素子および駆動回路素子の断面構造図であり、図 2 はそれを用いた模式的な回路構成を示す。

【0025】

図 1（a）は、本発明に用いられるスイッチ素子の一例を示しており、101 は第 1 導電型の半導体基体、102 は第 2 導電型の第 1 の半導体領域であるウェル領域、103 はゲート絶縁膜、104 はゲート電極、105 は第 1 導電型の第

2の半導体領域であるベース領域、107はゲート電極の左端部に整合しているソース領域、108はウエル領域とベース領域とのPN接合端部から図中右側に離れ、更にはゲート電極からも横方向に離れた高濃度のドレイン領域である。

【0026】

図1(a)に示すスイッチ素子は、予め十分深く形成したウエル領域102上にベース領域105を形成する。このウエル領域102とベース領域105は、それぞれMIS型電界効果トランジスタにおいて、ドレインとチャネルの役割を果たすこととなる。そのため、通常のチャネルとなる領域内に不純物を導入してドレインを形成する順序とは逆に、ドレインとなる領域内に不純物を導入してチャネルを形成することから、ドレインの濃度をチャネルの濃度より低く設定することが可能である。トランジスタの耐圧はこのドレインの耐圧で決定され、その耐圧は通常、ドレインの濃度が低いほど、ドレインの深さが深いほど高くなる。このため、定格電圧を高く設定でき、大電流化を可能とし、高速動作を実現できる。

【0027】

また、本発明によるMIS型電界効果トランジスタの実効チャネル長は、ベース領域105とソース領域107との横方向拡散量の差で決定される。この横方向拡散量は物理的係数に基づき決定されるため、実効チャネル長は従来より短く設定でき、オン抵抗を低減することができる。このオン抵抗の低減は、単位寸法における電流の流せる量を大きくすることにつながり、高速動作、省エネルギー、および高集積化が可能となる。

【0028】

また、このベース領域105とソース領域107はどちらもゲート電極104をマスクとしたイオンの導入により自己整合的（セルフアライン）に形成されるため、アライメントによる寸法差を生じることがなく、MIS型電界効果トランジスタのしきい値をばらつきなく製造することができ、高歩留りを実現し、高信頼性を得られる。

【0029】

更には、必要に応じてベース領域105の深さをウエル領域102の底よりも

深くして、半導体基体につながるように形成することも好ましいものである。

【0030】

図1 (b) は、図1 (a) のスイッチ素子を駆動するための回路中に含まれる素子であり、111は第1導電型の半導体基体、113はゲート絶縁膜、114はゲート電極、116は低濃度ドレイン領域、117はゲート電極の左端部に整合しているソース領域、118はゲート電極から横方向に離れた高濃度のドレイン領域である。

【0031】

ドレイン領域118側に電界緩和ドレイン領域（低濃度ドレイン領域）116を備え、チャネルと低濃度ドレインとのPN接合端部から、高濃度ドレイン領域118が離れ、更にはゲート電極からも離れているため、通常のゲート電極に対してセルフアラインでソース・ドレイン領域を形成するMIS型電界効果トランジスタに比してソース・ドレイン間の耐圧を高く設定できる。

【0032】

また、チャネル長を自由に設計できるため、任意のしきい値電圧を設定でき、バックゲート電圧に耐えるアナログ特性を有し、自由な設計が可能となる。

【0033】

そして、図1の(a)，(b)に示したトランジスタは、基体101と111をシリコン基板などの共通基体を用いて一体化できる。これにより、図2のような簡単な回路構成が実現できる。

【0034】

図2において、RHは電気熱変換体のような負荷であり、その低電位側VGN_{DH}には、図1 (a) のようなトランジスタがスイッチ素子として接続されている。スイッチ素子のゲートにはCMOSインバータが接続され、CMOSインバータの入力端子にはアンドゲートが接続されている。CMOSインバータの高電位側の基準電圧VHTを与えるレベルシフト素子には、図1 (b) のようなトランジスタが用いられている。CMOSインバータを構成するトランジスタやアンドゲートを構成するトランジスタは、図1 (a) や (b) とは異なる低濃度ドレイン領域（電界緩和ドレイン領域）のない一般的なMOSトランジスタで構成で

きる。

【 0 0 3 5 】

好ましくは図 3 に示すように、同一基板上にアレイ状に複数のスイッチ素子を配置した構造にすれば、ウエル領域 3 0 2 を分離する形にベース領域 3 0 5 を深く形成する構造のため、各セグメントの各ドレインを個々に電氣的に分離できる。これにより、本発明の半導体装置をアレイ状に配置し、記録装置として使用する場合でも、図 4 に示すような簡単な回路構成で実現でき、低コスト化が可能となる。図 4 において、ユニット 1 ～ユニット 3 は電気熱変換体のような負荷を、トランジスタ $Tr 1 \sim Tr 3$ は上述したスイッチ素子を示している。

【 0 0 3 6 】

次に、本発明による半導体装置の製造工程を示すが、以下の実施の形態に限定されることはなく、本発明の目的が達成され得るものであれば良い。

【 0 0 3 7 】

(第 1 の実施の形態)

第 5 図 (a) ～ (e) は、本発明に係る第 1 の実施形態の製造工程毎の断面図である。第 5 図 (a) に示すように、p 型半導体基体 5 0 1 の表面に、n 型のウエル領域 5 0 2 を形成する。この n 型のウエル領域 5 0 2 は p 型半導体基体 5 0 1 上にイオン注入法等を用いて、選択的に形成する。また、n 型のウエル領域 5 0 2 を p 型半導体基体 5 0 1 全面にエピタキシャル成長法を用いて形成して、p 型のウエル領域を選択的に形成することも可能である。

【 0 0 3 8 】

次に図 5 (b) に示すように、n 型のウエル領域 5 0 2 上に、例えば水素燃焼酸化により膜厚約 5 0 nm のゲート酸化膜 5 0 3 を成長させ、ゲート酸化膜 5 0 3 上に、例えば LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) 法により膜厚約 3 0 0 nm の多結晶シリコンを堆積する。この多結晶シリコンには LPCVD 法で堆積すると同時に、例えばリンをドーピングしたり、または堆積後に、例えばイオン注入法や固相拡散法を用いて、例えばリンをドーピングして所望の配線抵抗値となるようにする。その後、フォトリソグラフィによりパターンニングを行ない、多結晶シリコン膜をエッチングする。これにより MIS 型電界効果

トランジスタのゲート電極 5 0 4、5 1 4 が形成できる。この際、第 1 のゲート電極 5 0 4 は第 1 の n 型のウエル領域 5 0 2 上に形成し、第 2 のゲート電極 5 0 4 は半導体基体の表面上に形成する。

【 0 0 3 9 】

次に第 5 図 (c) に示すように、不図示のフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィによりパターニングを行ない、またゲート電極 5 0 4 をマスクとして、選択的に p 型の不純物、例えばボロンをイオン注入して、さらに電気炉で例えば 1 1 0 0 ℃、6 0 分の熱処理を行ない、ウエル領域 5 0 2 中にベース領域 5 0 5 を形成する。この熱処理は、M I S 型電界効果トランジスタ 5 3 0 のチャネル領域を決定することになるため、ウエル領域 5 0 2 の深さ、濃度、不純物の種類、またベース領域 5 0 5 の濃度、および不純物の種類により決定される。

【 0 0 4 0 】

次に第 5 図 (d) に示すように、不図示のフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィによりパターニングを行ない、またゲート電極 5 1 4 をマスクとして、選択的に n 型の不純物、例えばリンをイオン注入し、ゲート電極 5 1 4 の右端部に整合した電界緩和ドレイン領域 5 1 6 を形成する。この電界緩和ドレイン領域 5 1 6 は M I S 型電界効果トランジスタ 5 4 0 の耐圧とオン抵抗を決定する主要素となっている。そのため、この際所望の濃度と深さを得るために、電気炉で例えば 1 0 0 0 ℃、3 0 分の熱処理を行なっても良い。

【 0 0 4 1 】

次に第 5 図 (e) に示すように、第 1 のソース領域 5 0 7、第 1 のドレイン領域 5 0 8、第 2 のソース領域 5 1 7、第 2 のドレイン領域 5 1 8 を、例えばヒ素をイオン注入して、さらに電気炉で例えば 9 5 0 ℃、3 0 分の熱処理を行なって形成する。このうち第 1 のソース領域 5 0 7 と第 2 のソース領域 5 1 7 をそれぞれゲート電極をマスクにしたイオン注入により形成することで、第 1 のソース領域 5 0 7 と第 2 のソース領域 5 1 7 をゲート電極に自己整合させることができる。

【 0 0 4 2 】

その後、図示しないが C V D 法により酸化膜を堆積して層間絶縁膜を形成し、

コンタクトを開口し、配線を結線し集積回路を完成させる。必要に応じて多層配線を用いても良い。

【0043】

ここで、主要部のより詳しい製造法について説明する。MIS型電界効果トランジスタ540は、MIS型電界効果トランジスタ530に比して、オン抵抗は高くても支障ない。これは大電流を流す必要がないためである。また、動作耐圧もある程度確保されていれば支障ない。そのため、電界緩和ドレイン領域516を形成する際のイオン打込量は、第2のドレイン領域518の $1/10 \sim 1/10000$ 程度が適当で、またその深さもベース領域505の $2/3 \sim 1/10$ 程度で十分である。

【0044】

また、第2のドレイン領域518はゲート電極514から距離d1を空けて形成する。この距離d1はMIS型電界効果トランジスタ530とのバランスから一定ではないが、 $1.0 \sim 5.0 [\mu m]$ 程度が適当である。

【0045】

このようにして作成されたMIS型電界効果トランジスタ530のVDS-ID（ドレイン電圧ードレイン電流）特性と、VG-ID（ゲート電圧ードレイン電流）特性、VG-ABSIW（ゲート電圧ーウェハ電流の絶対値）特性を図6（a），（b）に示し、同様にMIS型電界効果トランジスタ540のVDS-ID特性と、VG-ID，ABSIW特性を図7（a），（b）に示す。このようにMIS型電界効果トランジスタの動作範囲は負荷抵抗Rにより制御され、またその動作耐圧はABSIWで表せる基板（ウェハ）電流値の動作範囲内での最大値により決定される。

【0046】

上記のように作成された、MIS型電界効果トランジスタ540は、MIS型電界効果トランジスタ530に対し、オン抵抗が1倍以上で、且つ動作耐圧が $2/3$ 倍以下とすることができる。また、MIS型電界効果トランジスタ540は、MIS型電界効果トランジスタ530に対し、オン抵抗が1倍以上で、且つ動作範囲内での最大基板電流が10倍以上とすることができる。

【 0 0 4 7 】

(第 2 の実施の形態)

図 8 は、本発明に係る第 2 の実施形態として、本発明の半導体装置をアレイ状に配置し、記録装置として使用する場合を目的とした工程断面図である。図 8 (a), (b) の工程は第 1 の実施形態と同様なので、その後から説明する。

【 0 0 4 8 】

図 8 (c) に示すように、不図示のフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィによりパターニングを行ない、またゲート電極 8 0 4 をマスクとして、選択的に p 型の不純物、例えばボロンをイオン注入して、さらに電気炉で例えば 1 1 0 0 ℃、1 8 0 分の熱処理を行ない、ウェル領域 8 0 2 を電氣的に分離するベース領域 8 0 5 を形成する。この熱処理はウェル領域 8 0 2 を分離するように、ベース領域 8 0 5 がウェル領域 8 0 2 より深くなるように設計することが重要であり、熱処理の条件はウェル領域 8 0 2 の深さ、濃度、不純物の種類、またベース領域 8 0 5 の濃度、および不純物の種類により決定される。

【 0 0 4 9 】

次に第 8 図 (d) に示すように、不図示のフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィによりパターニングを行ない、またゲート電極 8 1 4 をマスクとして、選択的に n 型の不純物、例えばリンをイオン注入し、ゲート電極 8 1 4 の右端部に整合した電界緩和ドレイン領域 8 1 6 を形成する。この電界緩和ドレイン領域 8 1 6 は M I S 型電界効果トランジスタ 8 4 0 の耐圧とオン抵抗を決定する主要素となっている。そのため、この際所望の濃度と深さを得るために、電気炉で例えば 1 0 0 0 ℃、3 0 分の熱処理を行なっても良い。

【 0 0 5 0 】

次に図 8 (e) に示すように、第 1 のソース領域 8 0 7、第 1 のドレイン領域 8 0 8、第 2 のソース領域 8 1 7、第 2 のドレイン領域 8 1 8 を、例えばヒ素をイオン注入して、さらに電気炉で例えば 9 5 0 ℃、3 0 分の熱処理を行なって形成する。このうち第 1 のソース領域 8 0 7 と第 2 のソース領域 8 1 7 をそれぞれゲート電極をマスクにしたイオン注入により形成することで、第 1 のソース領域 8 0 7 と第 2 のソース領域 8 1 7 をゲート電極に自己整合させることができる。

距離 d_2 は上述した距離 d_1 と同様に設計すればよい。

【0051】

その後、図示しないがCVD法により酸化膜を堆積して層間絶縁膜を形成し、コンタクトを開口し、配線を結線する。必要に応じて多層配線を行ない、集積回路を完成させる。

【0052】

本発明によれば、ウェル領域802を分離する形にベース領域805を深く形成する構造のため、各セグメントの各ドレインを個々に電氣的に分離できる。これにより、本発明の半導体装置をアレイ状に配置し、記録装置として使用する場合でも、図4に示すような簡単な回路構成で実現でき、低コスト化が可能となる。

【0053】

以上述べたように、本発明の半導体装置およびその製造方法においては、スイッチ素子のドレインの濃度をチャネルの濃度より低く設定でき、且つドレインを十分深く形成できるため、高耐圧により大電圧化を可能とし、低いオン抵抗による高速動作と大電流化を可能とし、延いては高集積化と省エネルギー化が得られ、またスイッチ素子を駆動するための回路には、アナログ特性を有した中耐圧素子を有するため、製造コストを大幅に上げることなく、自由な設計と高性能な半導体装置が実現できる。

【0054】

本発明の実施形態によるインクジェットヘッドは、上述したように作製した半導体装置の不図示の絶縁層上にアルミニウムなどからなる配線と窒化タンタルなどからなる発熱抵抗層とを有する発熱抵抗体を形成し、吐出口やそれに連通するインク通路を形成するために、成形樹脂やフィルムなどからなる天板などの吐出口形成部材を組合わせれば作製できる。（図10参照）そして、インクタンクを接続して、プリンター本体に搭載すればインクジェットプリンタとなる。

【0055】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、スイッチ素子に用いるMIS型電界効

果トランジスタのドレインの濃度をチャネルの濃度より低く設定でき、且つドレインを十分深く形成できるため、高耐圧により大電流化を可能とし、低いオン抵抗による高速動作を可能とし、延いては高集積化と省エネルギー化が実現できる。また、複数のトランジスタによるアレイ状の構成を必要とする半導体装置においても、コストを上げることなく、素子間の分離が容易に可能となる。

【 0 0 5 6 】

さらにスイッチ素子を駆動するための回路に、任意のしきい値電圧を設定でき、バックゲート電圧に耐えるアナログ特性を有した中耐圧素子を形成できるため、自由な設計と高性能な半導体装置が実現できる。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

(a) は本発明によるスイッチ素子、(b) は本発明による駆動回路素子の断面構造図。

【図 2】

本発明の半導体装置を記録装置に使用する場合の結線例を示す図。

【図 3】

本発明によるスイッチ素子をアレイ状に配置した半導体装置の断面構造図。

【図 4】

本発明のアレイ状に素子を配置した半導体装置を用いる場合の結線例を示す図。

【図 5】

(a) ～ (e) は、本発明に係る第 1 の実施形態の製造工程を示す断面図。

【図 6】

(a) , (b) は本発明によるスイッチ素子の電気特性を示す図。

【図 7】

(a) , (b) は本発明による駆動回路素子の電気特性を示す図。

【図 8】

(a) ～ (e) は、本発明に係る第 2 の実施形態の製造工程を示す断面図。

【図 9】

従来の記録ヘッドの模式的断面図。

【図 1 0】

記録ヘッドの模式的断面図。

【図 1 1】

一般的なドライバ I C の信号結線例を示す図。

【図 1 2】

レベルシフト結線例を示す図。

【図 1 3】

ソースホロワのトランジスタをレベルシフト回路に組み込んだときのドライバ I C 結線例を示す図。

【符号の説明】

1 0 1, 1 1 1, 3 0 1, 5 0 1, 8 0 1, 9 0 1, 1 0 0 1 p 型の半導体
基体

1 0 2, 3 0 2, 5 0 2, 8 0 2, 1 0 0 2 n 型のウエル領域

9 1 2 p 型のウエル領域

1 0 3, 1 1 3, 3 0 3, 5 0 3, 8 0 3 ゲート酸化膜

1 0 4, 1 1 4, 3 0 4, 5 0 4, 8 0 4, 8 1 4, 9 1 4, 1 0 1 4 ゲー
ト電極

3 0 5, 5 0 5, 8 0 5, 1 0 0 5 p 型のベース領域

1 1 6, 5 1 6, 8 1 6, 9 1 6 n 型の電界緩和ドレイン領域

1 0 7, 1 1 7, 3 0 7, 5 0 7, 5 1 7, 8 0 7, 8 1 7, 9 0 7, 1 0 0
7 n 型のソース領域

1 0 8, 1 1 8, 3 0 8, 5 0 8, 5 1 8, 8 0 8, 8 1 8, 9 0 8, 1 0 0

8 n 型のドレイン領域

9 1 7, 1 0 1 7 蓄熱層

9 1 8, 1 0 1 8 熱抵抗層

9 1 9, 1 0 1 9 配線

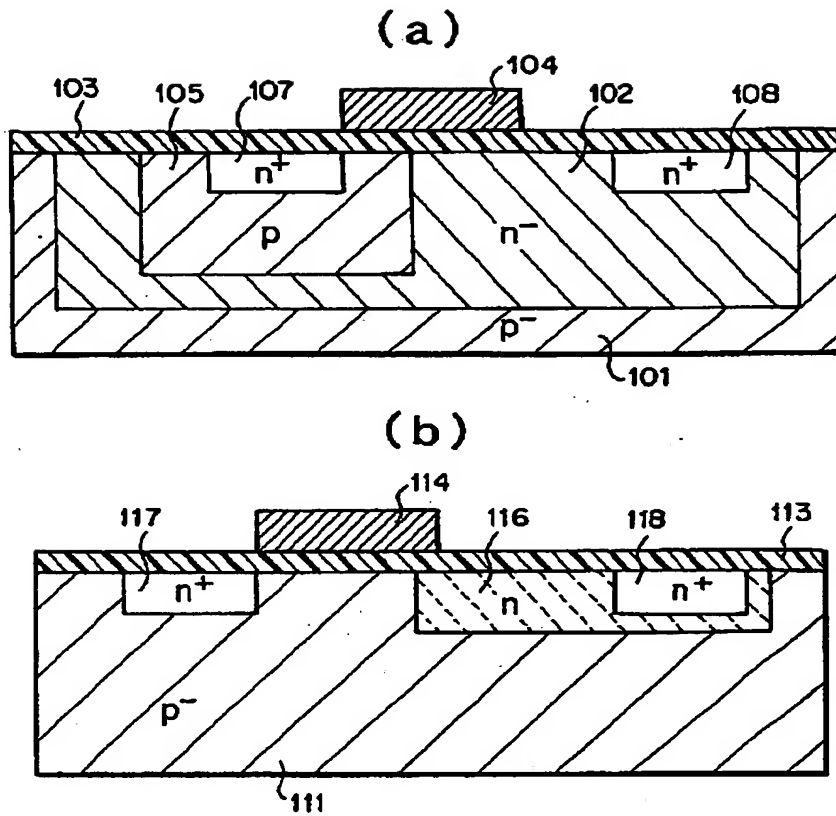
9 2 0, 1 0 2 0 保護層

5 3 0, 8 3 0, 9 3 0, 1 0 3 0 スイッチ素子

5 4 0 , 8 4 0 レベルシフト素子
9 4 0 , 1 0 4 0 記録ヘッドの基体
9 5 0 , 1 0 5 0 発熱部
9 6 0 , 1 0 6 0 インク吐出部
9 7 0 , 1 0 7 0 天板
9 8 0 , 1 0 8 0 液路

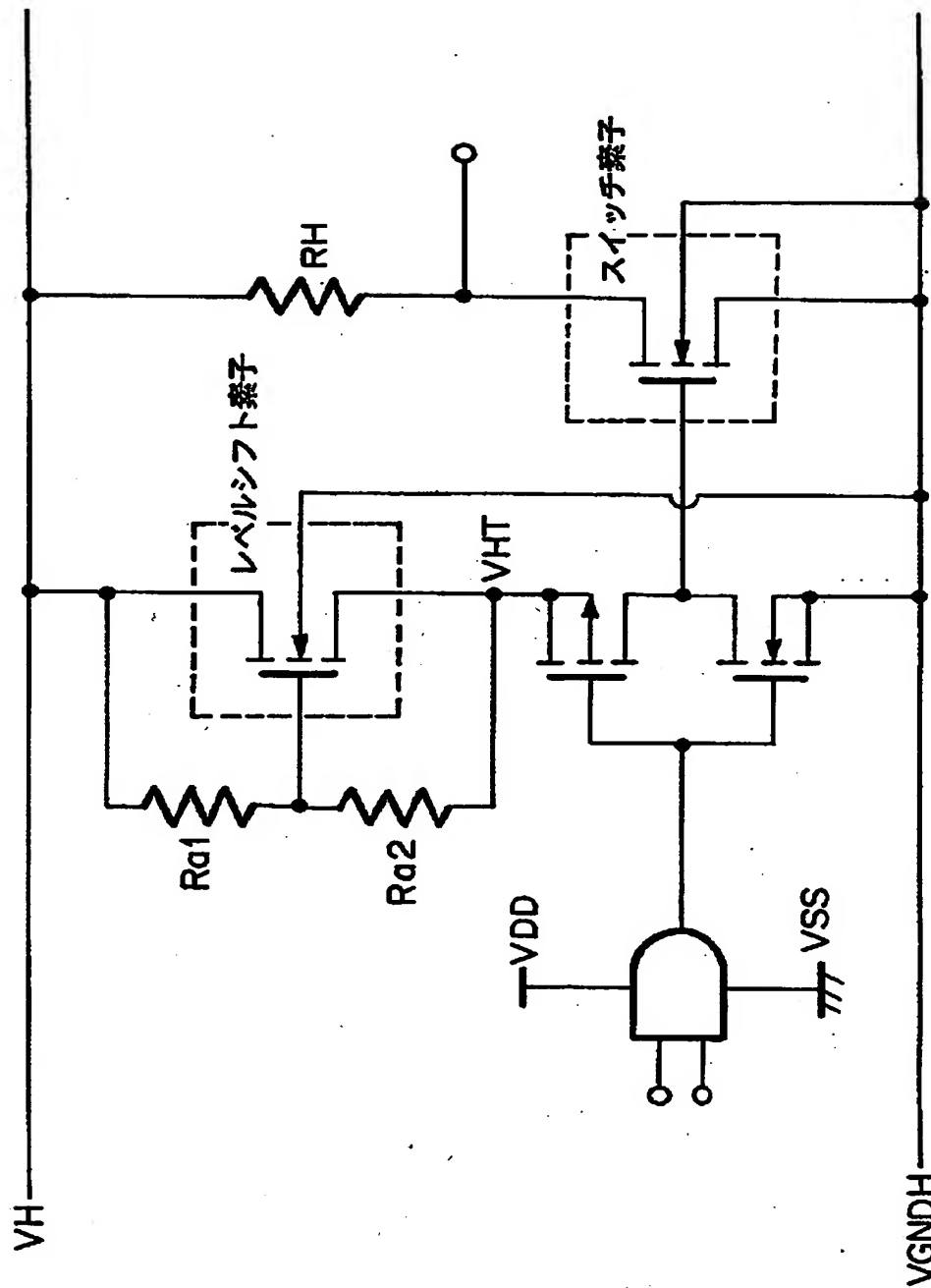
【書類名】 図面

【図 1】

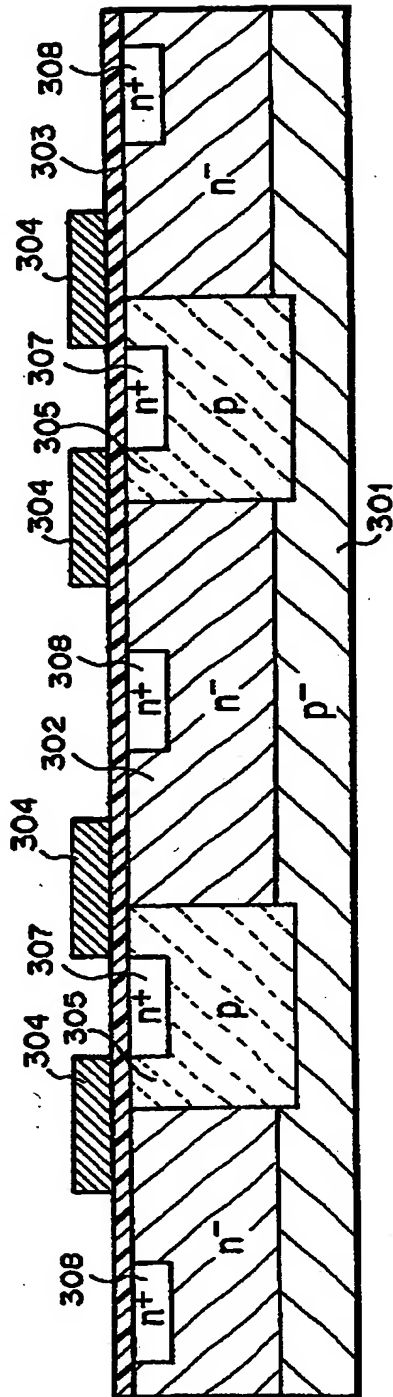


- 101, 111 : p型の半導体基体
- 102 : n型のウエル領域
- 103, 113 : ゲート酸化膜
- 104, 114 : ゲート電極
- 105 : p型のベース領域
- 116 : n型の電界緩和ドレイン領域
- 107, 117 : n型のソース領域
- 108, 118 : n型のドレイン領域

【図 2】

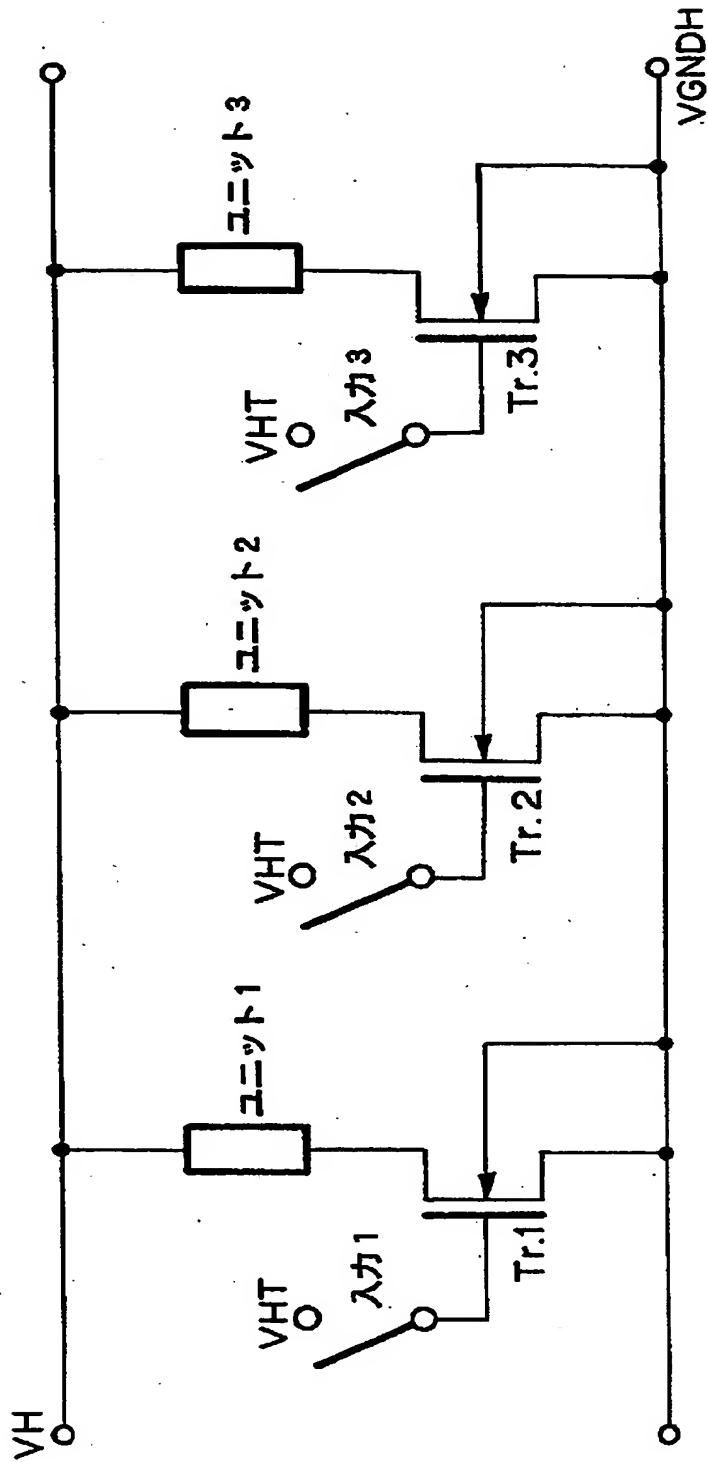


【図 3】

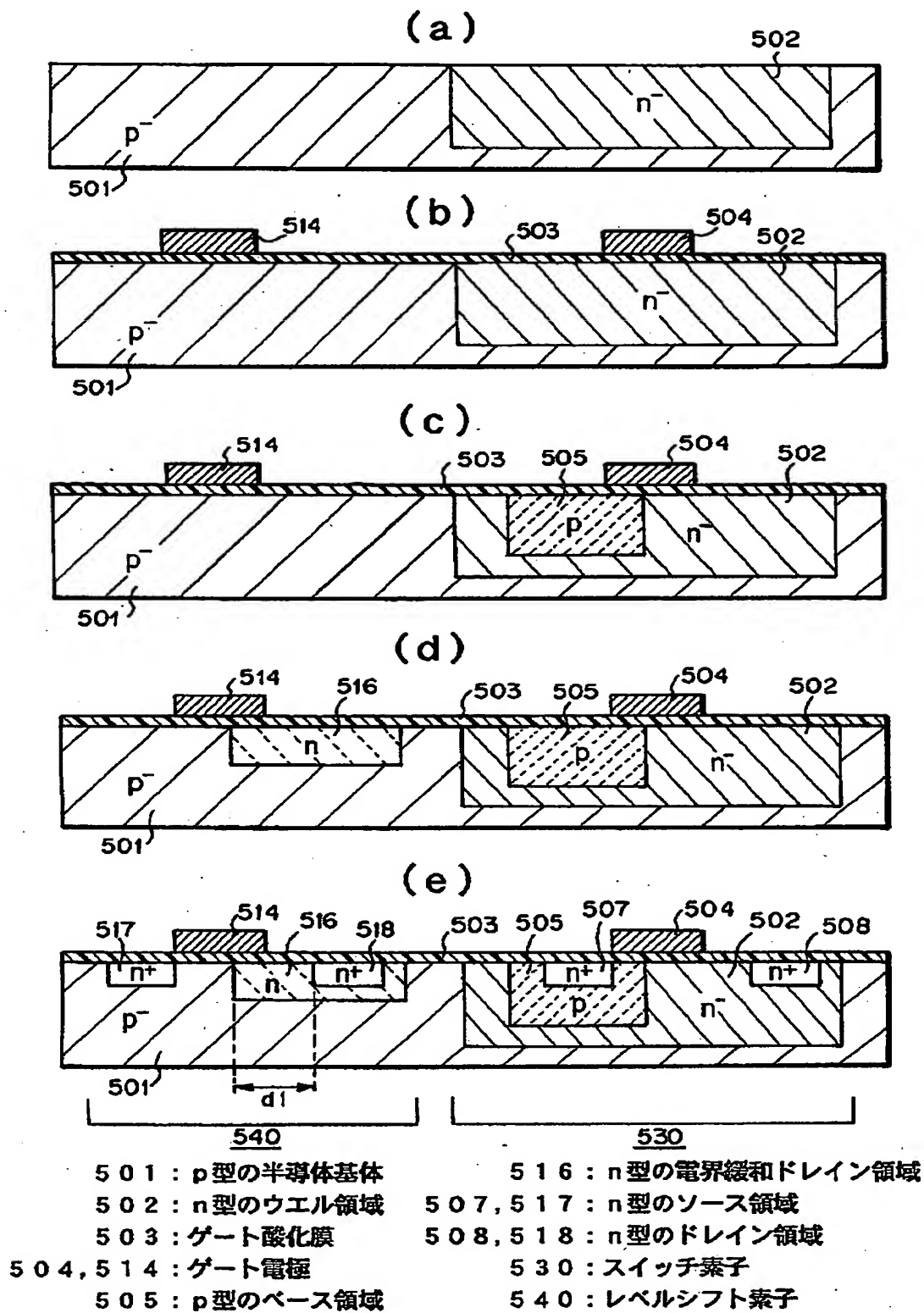


- 301 : p型の半導体基体
- 302 : n型のウェル領域
- 303 : ゲート酸化膜
- 304 : ゲート電極
- 305 : p型のベース領域
- 307 : n型のソース領域
- 308 : n型のドレイン領域

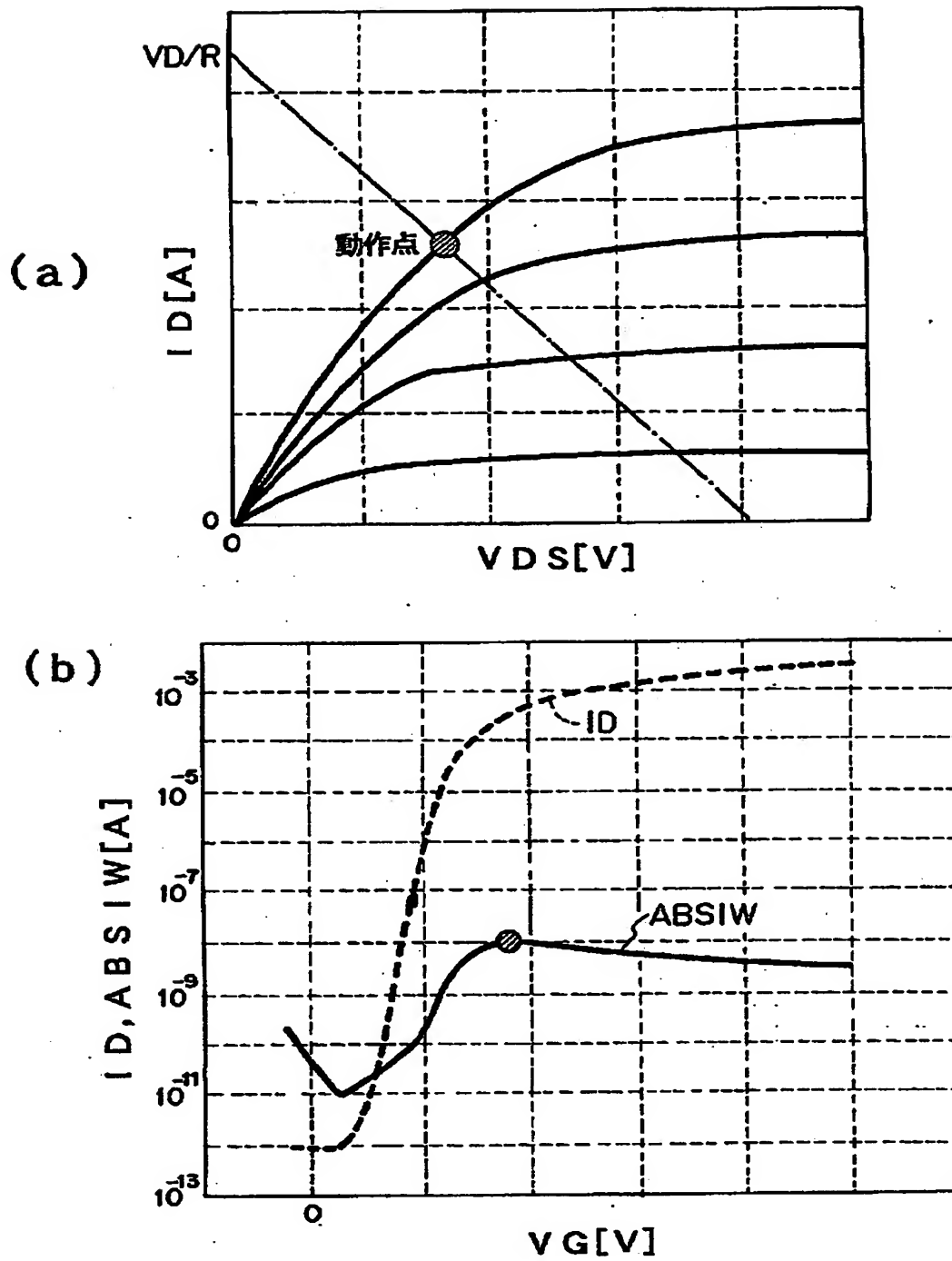
【図 4】



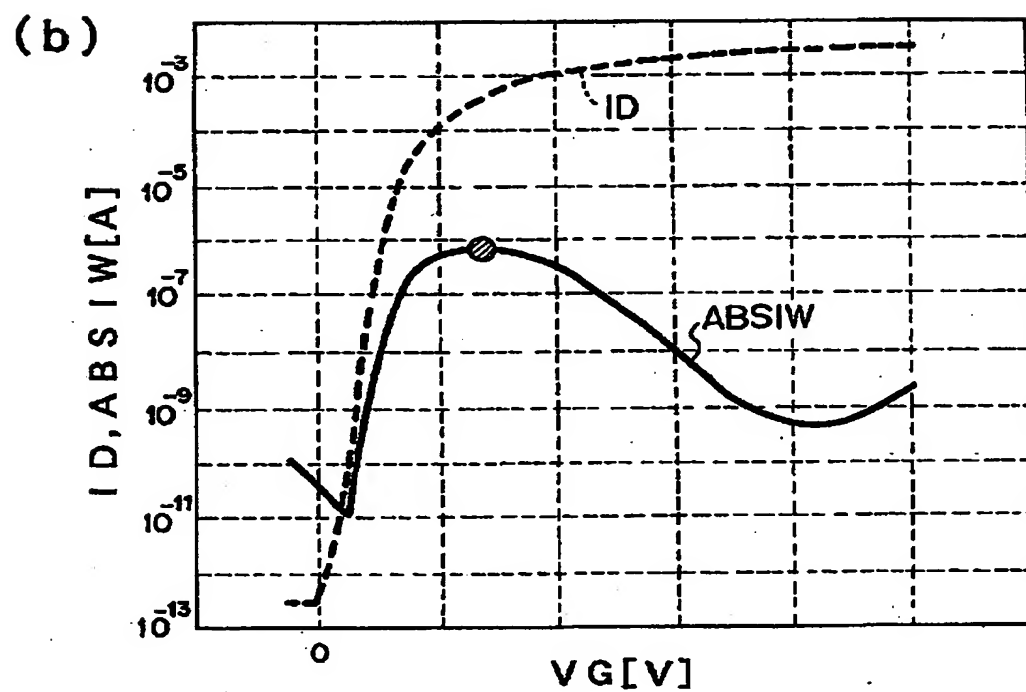
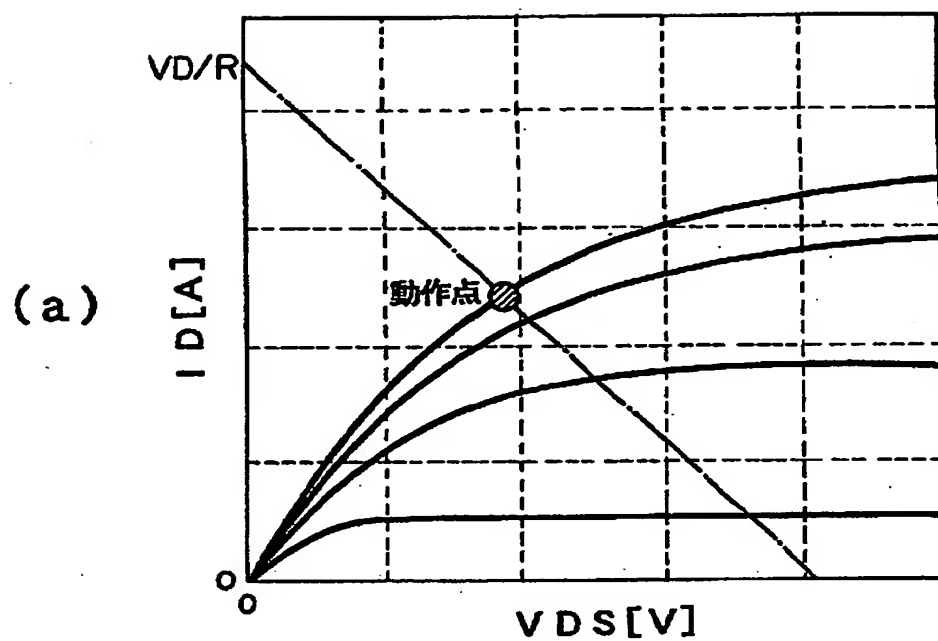
【図 5】



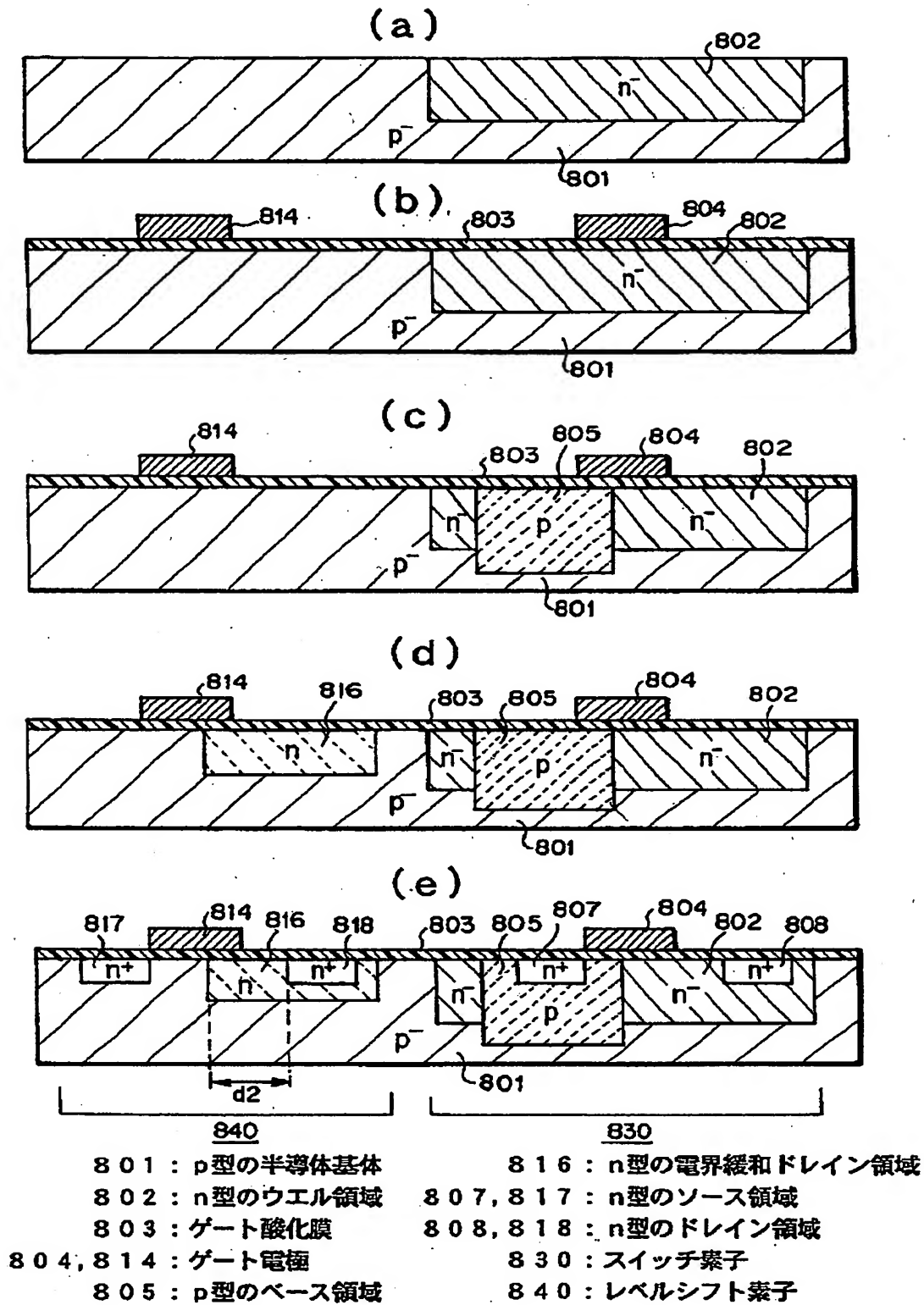
【図 6】



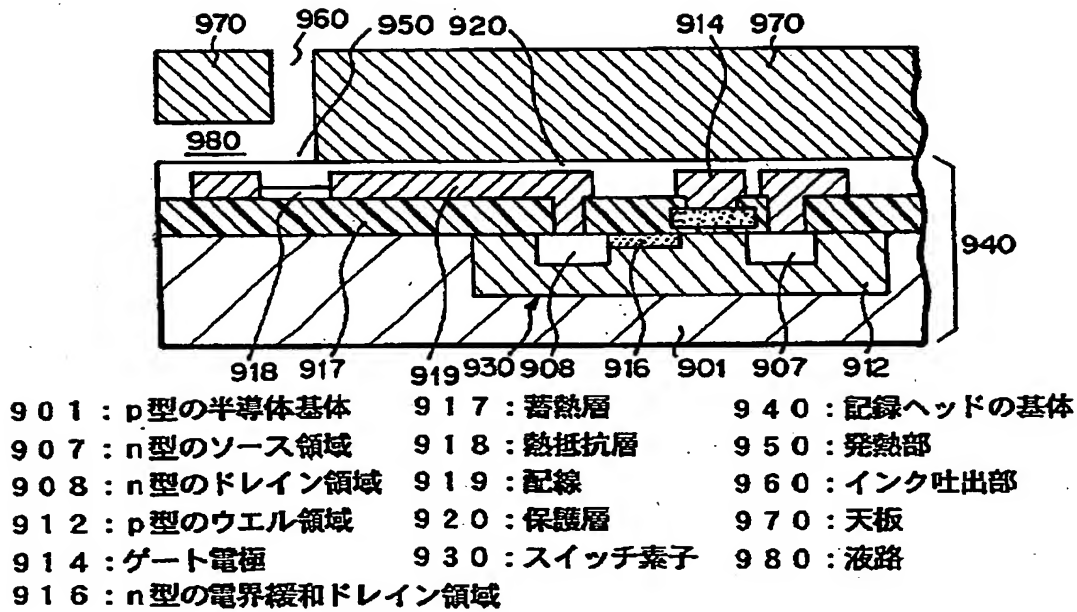
【図7】



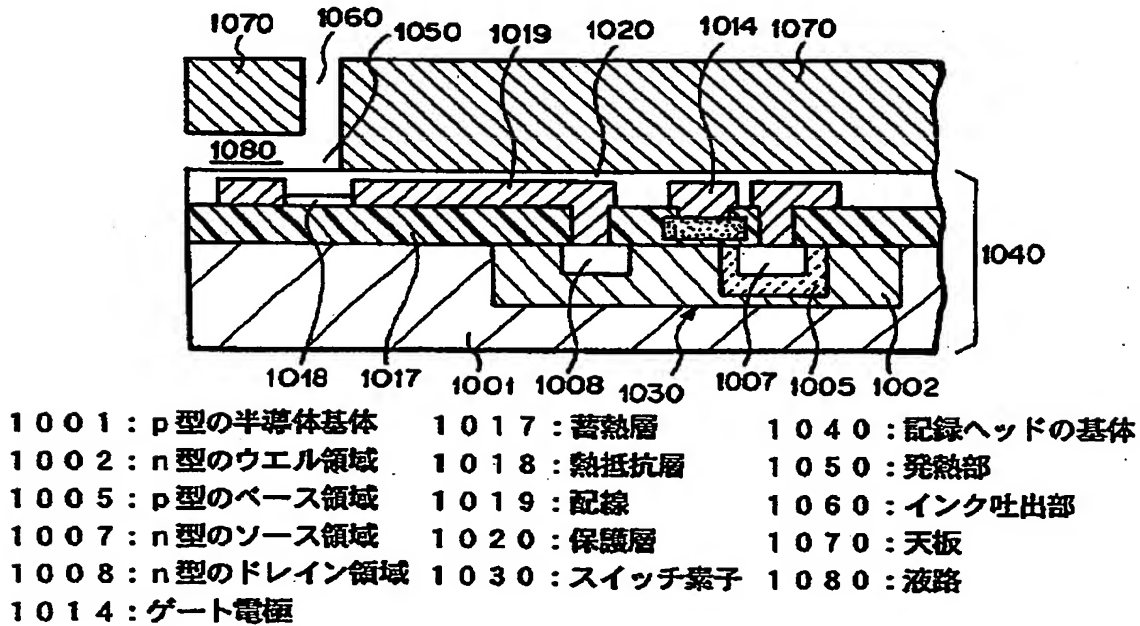
【図 8】



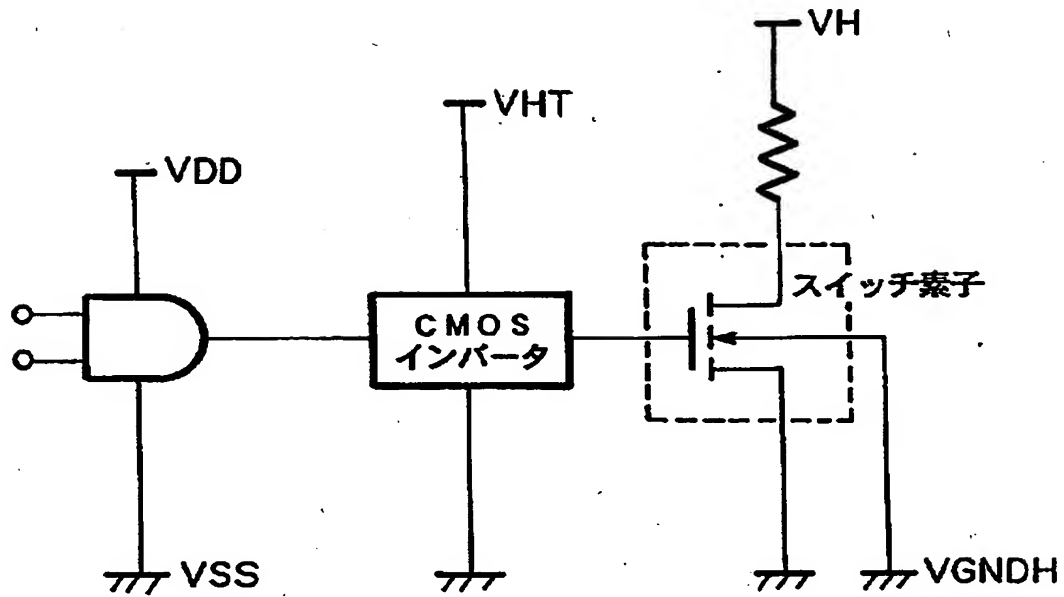
【図9】



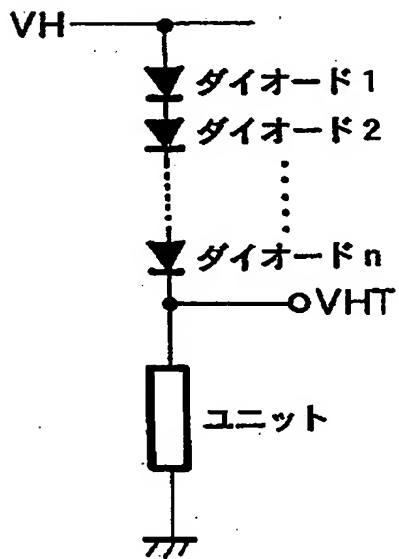
【図10】



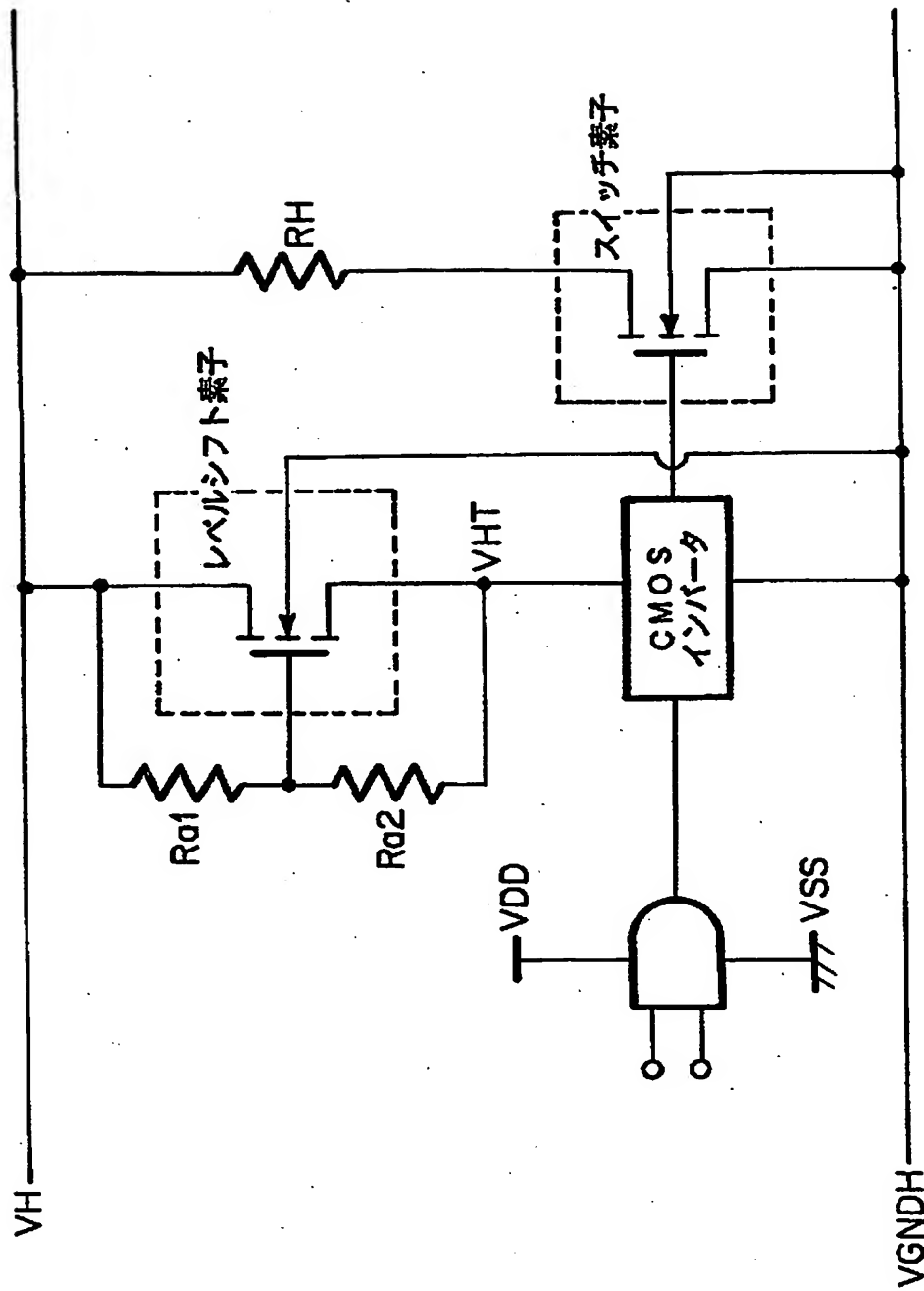
【図 1 1】



【図 1 2】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 大電流、高耐圧で高速駆動、省エネルギー、高集積化、および低コスト化が達成できる、MIS型電界効果トランジスタを含む高性能な半導体装置を提供する。

【解決手段】 予め十分深く形成したウエル領域102上にベース領域105を形成する。このウエル領域102とベース領域105は、それぞれMIS型電界効果トランジスタにおいて、ドレインとチャネルの役割を果たす。そのため、通常のチャネルの上にドレインを形成する形状とは逆に、ドレインの上にチャネルを形成することから、ドレインの濃度をチャネルの濃度より低く設定することが可能である。トランジスタの耐圧はこのドレインの耐圧で決定され、その耐圧は通常、ドレインの濃度が低いほど、ドレインの深さが深いほど高くなるので、定格電圧を高く設定でき、大電流化を可能とし、高速動作を実現できる。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名 キヤノン株式会社